

Сведения о ведущей организации
по диссертации Васильченко Александра Анатольевича
«Теоретическое исследование коллективных явлений
в электронных и электронно-дырочных системах в низкоразмерных структурах»
на соискание ученой степени доктора физико-математических наук
по специальности 01.04.07 – Физика конденсированного состояния

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томский государственный университет, НИ ТГУ, ТГУ
Место нахождения	Томская область, г. Томск
Почтовый индекс, адрес	634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Телефон	8 (3822) 52-98-52
Адрес электронной почты	rector@tsu.ru
Адрес официального сайта	www.tsu.ru
Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	
1.	Lozovoy K. A. Critical thickness of transition from 2D to 3D growth and peculiarities of quantum dots formation in $\text{Ge}_{1-x}\text{Sn}_x/\text{Si}$ and $\text{Ge}_{1-y}\text{Sny}/\text{Si}$ systems / K. A. Lozovoy, A. P. Kokhanenko, A. V. Voitsekhovskii // Surface Science. – 2018. – Vol. 669. – P. 45–49. – DOI: 10.1016/j.susc.2017.11.006. (<i>Web of Science</i>).
2.	Izhnin I. I. Nanostructures with Ge-Si quantum dots for infrared photodetectors / I. I. Izhnin, O. I. Fitsych, A. V. Voitsekhovskii, A. P. Kokhanenko, K. A. Lozovoy, V. V. Dirko // Opto-Electronics Review. – 2018. – Vol. 26, is. 3. – P. 195–200. – DOI: 10.1016/j.opelre.2018.06.002. (<i>Web of Science</i>).
3.	Izhnin I. I. Temperature spectra of conductance of Ge/Si p-i-n structures with Ge quantum dots / I. I. Izhnin, O. I. Fitsych, A. A. Pishchagin, A. P. Kokhanenko, A. V. Voitsekhovskii, S. M. Dzyadukh, A. I. Nikiforov // Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol. 12. – P. 131 (1–5). – DOI: 10.1186/s11671-017-1916-0. (<i>Web of Science</i>).
4.	Voitsekhovskii A. V. Interface properties of MIS structures based on hetero-epitaxial graded-gap $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ with CdTe interlayer created in situ during MBE growth / A. V. Voitsekhovskii, S. N. Nesmelov, S. M. Dzyadukh, V. S. Varavin, S. A. Dvoretzky, N. N. Mikhailov, M. V. Yakushev, G. Yu. Sidorov // Superlattices and Microstructures. – 2017. – Vol. 111. – P. 1195–1202. – DOI: 10.1016/j.spmi.2017.08.025. (<i>Web of Science</i>).
5.	Otrokov M. M. Unique Thickness-Dependent Properties of the van der Waals Interlayer Antiferromagnet MnBi_2Te_4 Films / M. M. Otrokov, I. P. Rusinov, M. Blanco-Rey, M. Hoffman, A. Y. Vyazovskaya, S. V. Eremeev, A. Ernst, P. M. Echenique, A. Arnau, E. V. Chulkov // Physical Review Letters. – 2019. – Vol. 122, is. 10. – P. 107202 (1–6). – DOI: 10.1103/PhysRevLett.122.107202. (<i>Web of Science</i>).
6.	Silkin I. V. Collective electronic excitations in Ti and Zr and their dihydrides / I. V. Silkin, I. P. Chernov, V. M. Silkin, E. V. Chulkov // Physical Review B. – 2018. – Vol. 98, is. 7. – P. 075111 (1–14). – DOI: 10.1103/PhysRevB.98.075111. (<i>Web of Science</i>).
7.	Rybkin A. G. Magneto-Spin-Orbit Graphene: Interplay between Exchange and Spin-Orbit Couplings / A. G. Rybkin, A. A. Rybkina, M. M. Otrokov, O. Yu. Vilkov, I. I. Klimovskikh, A. E. Petukhov, M. V. Filyanina, V. Yu. Voroshin, I. P. Rusinov, A. Ernst, A. Arnau, E. V. Chulkov, A. M. Shikin // Nano Letters. – 2018. – Vol. 18, is. 3. – P. 1564–1574. – DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b01548. (<i>Web of Science</i>).

8.	Sorokin D. A. Luminescence of crystals excited by a runaway electron beam and by excilamp radiation with a peak wavelength of 222 nm / D. A. Sorokin, A. G. Burachenko, D. V. Beloplotov, V. F. Tarasenko, E. X. Baksht, E. I. Lipatov, M. I. Lomaev // Journal of Applied Physics. – 2017. – Vol. 122, is. 15. – P. 154902 (1–6). – DOI: 10.1063/1.4996965. (<i>Web of Science</i>).
9.	Севастьянов Е. Ю. Свойства резистивных сенсоров водорода в зависимости от добавок 3d-металлов, введенных в объем тонких нанокристаллических пленок SnO ₂ / Е. Ю. Севастьянов, Н. К. Максимова, А. И. Потекаев, Н. В. Сергейченко, Е. В. Черников, А. В. Алмаев, Б. О. Кушнарв // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2017. – Т. 60, № 7. – С. 13–16. <i>в переводной версии журнала, входящей в Web of Science:</i> Sevastyanov E. Yu. Properties of resistive hydrogen sensors as a function of additives of 3d-metals introduced in the volume of thin nanocrystalline SnO ₂ films / E. Yu. Sevastyanov, N. K. Maksimova, A. I. Potekaev, N. V. Sergeichenko, E. V. Chernikov, A. V. Almaev, B. O. Kushnarev // Russian Physics Journal. – 2017. – Vol. 60, № 7. – P. 1094–1098. – DOI: 10.1007/s11182-017-1184-6.
10.	Brudnyi V. N. Electron Irradiation Degradation of AlGaInP/GaAs Light-Emitting Diodes / V. N. Brudnyi, I. A. Prudaev, V. L. Oleinik, A. A. Marmaluk // Physica status solidi (a). – 2018. – Vol. 215, is. 8. – P. 1700445(1–5). – DOI: 10.1002/pssa.201700445 (<i>Web of Science</i>).
11.	Brudnyi V. N. Electronic properties of SiC polytypes: Charge neutrality level and interfacial barrier heights / V. N. Brudnyi, A. V. Kosobutsky // Superlattices and Microstructures. – 2017. – Vol. 111. – P. 499–505. – DOI: 10.1016/j.spmi.2017.07.003. (<i>Web of Science</i>).
12.	Саркисов С. Ю. Расчеты из первых принципов оптических констант слоистых кристаллов GaSe и InSe / С. Ю. Саркисов, А. В. Кособутский, В. Н. Брудный, Ю. Н. Журавлев // Физика твердого тела. – 2015. – Т. 57, № 9. – С. 1693–1697. <i>в переводной версии журнала, входящей в Web of Science:</i> Sarkisov S. Yu. Ab initio calculations of optical constants of GaSe and InSe layered crystals / S. Yu. Sarkisov, A. V. Kosobutsky, V. N. Brudnyi, Yu. N. Zhuravlev // Physics of the Solid State. – 2015. – Vol. 57, is. 9. – P. 1735–1740. – DOI: 10.1134/S1063783415090309.
13.	Grinyaev S. N. Effects of size quantization in the spectra and $\Gamma - M$ transitions in (GaAs) _m (AlAs) _n (001) superlattices / S. N. Grinyaev, L. N. Nikitina, V. G. Tiuterev // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. – 2018. – Vol. 103. – P. 180–187. – DOI: 10.1016/j.physe.2018.05.034. (<i>Web of Science</i>).
14.	Grinyaev S. N. Peculiarities of tunneling current in w-AlN/GaN(0001) two-barrier structures induced by deep-level defects / S. N. Grinyaev, A. N. Razzhuvalov // Journal of Applied Physics. – 2016. – Vol. 120, is. 15. – P. 154302 (1–8). – DOI: 10.1063/1.4964876. (<i>Web of Science</i>).
15.	Guo J. Limiting pump intensity for sulfur-doped gallium selenide crystals / J. Guo, D.-J. Li, J.-J. Xie, L.-M. Zhang, Z.-S. Feng, Yu. M. Andreev, K. A. Kokh, G. V. Lanskii, A. I. Potekaev, A. V. Shajduko, V. A. Svetlichnyj // Laser Physics Letters. – 2014. – Vol. 1, № 11. – P. 1–6. – DOI: 10.1088/1612-2011/11/5/055401. (<i>Web of Science</i>).

09.09.2019

Верно

Проректор
по научной и инновационной деятельности

А. Б. Ворожцов